



CYPRESS[®]
EMBEDDED IN TOMORROW™

赛普拉斯产品蓝图：Flash存储器

Q2 2017



NOR Flash存储器系列的解码



HyperRAM™和HyperFlash™ NOR Flash存储器产品蓝图

产品系列	容量	(量产) [EOL]	2017				2018				2019				2020				2021			
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
S26KS-T 45 nm MB ¹ 1.8 V	4 Gb ² 2 Gb ² 1 Gb 512 Mb	(待定) (待定) (Q3'18) (Q2'18)																				
S26KS-S 65 nm MB ¹ 1.8 V	1 Gb ² 512 Mb 256 Mb 128 Mb	(待定)																				
S26KL-T 45 nm MB ¹ 3.0 V	4 Gb ² 2 Gb ² 1 Gb 512 Mb	(待定) (待定) (Q3'18) (Q2'18)																				
S26KL-S 65 nm MB ¹ 3.0 V	1 Gb ² 512 Mb 256 Mb 128 Mb	(待定)																				
S27KS-1 63 nm DRAM 1.8 V	256 Mb ² 128 Mb ² 64 Mb	(待定) (Q2'17)																				
S27KL-1 63 nm DRAM 3.0 V	256 Mb ² 128 Mb ² 64 Mb	(待定) (Q2'17)																				

¹ 混合扇区

² S70系列

除非另有说明，
所有器件都是长期性供货



HyperRAM™和HyperFlash™的产品系列

	HyperRAM™ S27KL-1 63 nm DRAM, 3.0 V	HyperRAM™ S27KS-1 63 nm DRAM, 1.8 V	HyperFlash S26KL-S 65 nm MB, 3.0 V	HyperFlash S26KL-T 45 nm MB, 3.0 V	HyperFlash S26KS-S 65 nm MB, 1.8 V	HyperFlash S26KS-T 45 nm MB, 1.8 V
≥ 256 Mb	容量 初始访问/DDR时钟 *温度范围			4 Gb ¹ 80 ns/200 MHz * I, A, V, B, M		4 Gb ¹ 80 ns/200 MHz * I, A, V, B, M
	除非另有说明, 所有器件 都是长期性供货			2 Gb ¹ 80 ns/200 MHz * I, A, V, B, M		2 Gb ¹ 80 ns/200 MHz * I, A, V, B, M
64 - 128 Mb			1 Gb ^{1, 2} 96 ns/100 MHz * I, A, V, B, N, M	1 Gb 80 ns/200 MHz * I, A, V, B, M	1 Gb ^{1, 2} 96 ns/166 MHz * I, A, V, B, N, M	1 Gb 80 ns/200 MHz * I, A, V, B, M
			512 Mb 96 ns/100 MHz * I, A, V, B, N ² , M ²	512 Mb Q317 80 ns/200 MHz * I, A, V, B, M	512 Mb 96 ns/166 MHz * I, A, V, B, N ² , M ²	512 Mb Q317 80 ns/200 MHz * I, A, V, B, M
	256 Mb ¹ 联系销售人员	256 Mb ¹ 联系销售人员	256 Mb 96 ns/100 MHz * I, A, V, B, N ² , M ²		256 Mb 96 ns/166 MHz * I, A, V, B, N ² , M ²	
	128 Mb ¹ Q217 36 ns/100 MHz * I, A, V, B	128 Mb ¹ Q217 36 ns/166 MHz * I, A, V, B	128 Mb 96 ns/100 MHz * I, A, V, B, N ² , M ²		128 Mb 96 ns/166 MHz * I, A, V, B, N ² , M ²	
	64 Mb 36 ns/100 MHz * I, A, V, B	64 Mb 36 ns/166 MHz * I, A, V, B				

*1 = 工业级: -40°C到+85°C
 A = 汽车级, AEC-Q100等级3: -40°C到+85°C
 V = 扩展的工业级: -40°C到+105°C
 B = 汽车级, AEC-Q100等级2: -40°C到+105°C
 N = 扩展范围: -40°C到+125°C
 M = 汽车级, AEC-Q100等级1: -40°C到+125°C

¹ S70串行(堆栈芯片)
² 联系销售人员

状态
 供货
 EOL (最后供货)

概念

开发中

采样
QQYY

量产
QQYY
QQYY



串行NOR Flash存储器产品蓝图

产品系列	容量	(量产) [EOL]	2017				2018				2019				2020				2021			
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
S25FS-T 45 nm MB ¹ 1.8 V	4 Gb ³ 2 Gb ³ 1 Gb 512 Mb	(待定) (待定) (Q3'18) (Q2'18)																				
S25FS-S 65 nm MB ¹ 1.8 V	1 Gb ³ 512 Mb 256 Mb 128 Mb 64 Mb																					
S25FL-T 45 nm MB ¹ 3.0 V	4 Gb ³ 2 Gb ³ 1 Gb 512 Mb	(待定) (待定) (Q3'18) (Q2'18)																				
S79FL-S 65 nm MB ¹ 3.0 V	1 Gb ⁴ 512 Mb ⁴ 256 Mb ⁴																					
S25FL-S 65 nm MB ¹ 3.0 V	1 Gb ³ 512 Mb 256 Mb 128 Mb ⁵																					
S25FL-P 90 nm MB ¹ 3.0 V	256 Mb ³ 128 Mb ⁶ 64 Mb 32 Mb	[Q4'17] [Q2'18] [Q1'18] [Q1'18]																				
S25FL-L 65 nm FG ² 3.0 V	256 Mb 128 Mb 64 Mb	(Q2'17)																				
S25FL1-K 90 nm FG ² 3.0 V	64 Mb 32 Mb 16 Mb	[Q1'18] [Q1'18] [Q1'18]																				

¹ 混合扇区

³ S70系列

⁵ S25FL127S & S25FL128S

² 统一扇区

⁴ S79 Dual Quad SPI

⁶ S25FL128P & S25FL129P

除非另有说明,
所有器件都是长期性供货



SPI NOR闪存存储器产品系列

	S25FL1-K 90 nm FG, 3.0 V 统一扇区 ¹	S25FL-L 65 nm FG, 3.0 V 统一扇区 ¹	S25FL-P 90 nm MB, 3.0 V 混合扇区 ¹	S25FL-S 65 nm MB, 3.0 V 混合扇区 ¹	S79FL-S ² 65 nm MB, 3.0 V 混合扇区 ¹	S25FL-T 45 nm MB, 3.0 V 混合扇区 ¹	S25FS-S 65 nm MB, 1.8 V 混合扇区 ¹	S25FS-T 45 nm MB, 1.8 V 混合扇区 ¹
≥ 256 Mb	容量 SDR时钟/DDR时钟 *温度范围					4 Gb ⁴ 166 MHz / 100 MHz * I、A、V、B、M		4 Gb ⁴ 166 MHz / 100 MHz * I、A、V、B、M
	除非另有说明, 所有器件 都是长期性供货					2 Gb ⁴ 166 MHz / 100 MHz * I、A、V、B、M		2 Gb ⁴ 166 MHz / 100 MHz * I、A、V、B、M
				1 Gb ⁴ 133 MHz/80 MHz * I、A、V、B、N、M	1 Gb 133 MHz/80 MHz * I、A、V、B	1 Gb 166 MHz / 100 MHz * I、A、V、B、M	1 Gb ⁴ 133 MHz/80 MHz * I、A、V、B、N、M	1 Gb 166 MHz / 100 MHz * I、A、V、B、M
64 - 128 Mb		256 Mb 133 MHz/66 MHz * I、A、V、B、M	256 Mb ⁴ Q417 104 MHz/-- * I、A	512 Mb 133 MHz/80 MHz * I、A、V、B、N、M	512 Mb 133 MHz/80 MHz * I、A、V、B	512 Mb Q317 166 MHz / 100 MHz * I、A、V、B、M	512 Mb 133 MHz/80 MHz * I、A、V、B、N、M	512 Mb Q317 166 MHz / 100 MHz * I、A、V、B、M
		128 Mb Q217 133 MHz/66 MHz * I、A、V、B、M	128 Mb ⁵ Q218 104 MHz/-- * I、A、V、B	128 Mb ⁷ 133 MHz / 80 MHz * I、A、V、B、N、M			128 Mb 133 MHz/80 MHz * I、A、V、B、M	
	64 Mb Q118 108 MHz/-- * I、A、V、B、N ³ 、M ³	64 Mb 108 MHz/54 MHz * I、A、V、B、M	128 Mb ⁶ Q218 104 MHz/-- * I、A、V、B	64 Mb Q118 104 MHz/-- * I、A、V、B	128 Mb ⁸ 108 MHz/-- * I、A、V、B			64 Mb 133 MHz/80 MHz * I、A、V、B、N、M
≤ 32 Mb	32 Mb Q118 108 MHz/-- * I、A、V、B、N ³ 、M ³		32 Mb Q118 104 MHz/-- * I、A、V、B					
	16 Mb Q118 108 MHz/-- * I、A、V、B、N ³ 、M ³							

¹ 逻辑扇区大小

² S79系列, Dual Quad SPI (堆叠裸片)

³ 联系销售人员

⁴ S70系列 (堆叠裸片)

⁵ S25FL129P Quad SPI

⁶ S25FL128P Dual SPI

⁷ S25FL128S 133 MHz SDR 80 MHz DDR

⁸ S25FL127S 108 MHz SDR

* I = 工业级: -40°C到+85°C

A = 汽车级, AEC-Q100等级3: -40°C到+85°C

V = 扩展的工业级: -40°C到+105°C

B = 汽车级, AEC-Q100等级2: -40°C到+105°C

N = 扩展范围: -40°C到+125°C

M = 汽车级, AEC-Q100等级1: -40°C到+125°C

状态
供货

概念
□

开发中
□

采样
□
QQYY

量产
□
QQYY

EOL (最后供货)



并行NOR Flash存储器产品蓝图

产品系列	容量	(量产) [EOL]	2017				2018				2019				2020				2021			
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
S29GL-T 45 nm MB ¹ 3.0 V	2 Gb ¹ 1 Gb 512 Mb		[量产]																			
S29GL-S 65 nm MB ¹ 3.0 V	2 Gb ¹ 1 Gb 512 Mb 256 Mb 128 Mb 64 Mb		[量产]																			
S29GL-P 90 nm MB ¹ 3.0 V	2 Gb ¹ 1 Gb 512 Mb	[Q3'17]	[EOL - LTB]																			
S29GL-P 90 nm MB ¹ 3.0 V	256 Mb 128 Mb		[量产]																			
S29GL-N 110 nm MB ¹ 3.0 V	64 Mb 32 Mb		[量产]																			
S29PL-J 110 nm FG ^{1, 2} 3.0 V	128 Mb 64 Mb 32 Mb		[量产]																			
S29JL-J 110 nm FG ² 3.0 V	64 Mb 32 Mb		[量产]																			
S29AL-J 110 nm FG 3.0 V	16 Mb 8 Mb		[量产]																			
S29AS-J 110 nm FG 1.8 V	16 Mb 8 Mb		[量产]																			

¹支持同时进行读/写操作 ²支持页模式 ³S70系列 (堆叠裸片)

除非另有说明,
所有器件都是长期性供货

概念
 量产
 EOL - LTB
 样片
 EOL - LTS

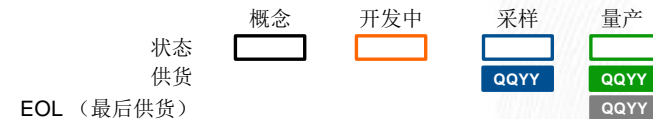


并行NOR Flash存储器产品系列

	S29AS-J 110 nm FG, 1.8 V	S29AL-J 110 nm FG, 3.0 V	S29JL-J ¹ 110 nm FG, 3.0 V	S29PL-J ^{1, 2} 110 nm FG, 3.0 V	S29GL-N ² 110 nm MB, 3.0 V	S29GL-P ² 90 nm MB, 3.0 V	S29GL-S ² 65 nm MB, 3.0 V	S29GL-T ² 45 nm MB, 3.0 V
≥ 256 Mb	容量 初始/页访问 *温度范围					2 Gb ³ Q317 110 ns/25 ns * I	2 Gb ³ 110 ns/20 ns * I, A, V, B	2 Gb ³ 110 ns/20 ns * I, A, V, B, N
	除非另有说明, 所有器件 都是长期性供货					1 Gb Q317 110 ns/25 ns * I	1 Gb 100 ns/15 ns * I, A, V, B	1 Gb 100 ns/15 ns * I, A, V, B, N
						512 Mb Q317 100 ns/25 ns * I	512 Mb 100 ns/15 ns * I, A, V, B	512 Mb 100 ns/15 ns * I, A, V, B, N
						256 Mb 90 ns/25 ns * I	256 Mb 90 ns/15 ns * I, A, V, B	
64 - 128 Mb				128 Mb 60 ns/20 ns * I, A		128 Mb 90 ns/25 ns * I	128 Mb 90 ns/15 ns * I, A, V, B	
			64 Mb 55 ns/-- * I, A	64 Mb 55 ns/20 ns * I, A	64 Mb 90 ns/25 ns * I, A		64 Mb 70 ns/15 ns * I, A, B	
			32 Mb 60 ns/-- * I, A	32 Mb 55 ns/20 ns * I, A	32 Mb 90 ns/25 ns * I, A			
≤ 32 Mb	16 Mb 70 ns/-- * I, A	16 Mb 55 ns/-- * I, A, N, M						
	8 Mb 70 ns/-- * I, A	8 Mb 55 ns/-- * I, A, N, M						

* I = 工业级: -40°C 到+85°C
 A = 汽车级, AEC-Q100等级3: -40°C到+85°C
 V = 扩展的工业级: -40°C 到+105°C
 B = 汽车级, AEC-Q100等级2: -40°C到+105°C
 N = 扩展范围: -40°C 到+125°C
 M = 汽车级, AEC-Q100等级1: -40°C到+125°C

¹ 支持同时进行读/写操作
² 支持页模式
³ S70系列 (堆叠裸片)



突发NOR Flash存储器产品蓝图

产品系列	容量 (量产) [EOL]	2017				2018				2019				2020				2021			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
S29WS-P 90 nm MB 1.8 V	512 Mb 256 Mb 128 Mb	[量产]																			
S29NS-P 90 nm MB 1.8 V	512 Mb	[量产]																			
S29VS-R 65 nm MB 1.8 V	256 Mb 128 Mb 64 Mb	[量产]																			
S29XS-R 65 nm MB 1.8 V	256 Mb 128 Mb 64 Mb	[量产]																			
S29CD-J 110 nm MB 2.5 V	32 Mb 16 Mb	[量产]																			
S29CL-J 110 nm MB 3.0 V	32 Mb 16 Mb	[量产]																			

除非另有说明，
所有器件都是长期性供货



突发NOR Flash存储器产品系列

	S29CL-J ¹ 110 nm FG, 3.0 V	S29CD-J ¹ 110 nm FG, 2.5 V	S29XS-R ² 65 nm MB, 1.8 V	S29VS-R ³ 65 nm MB, 1.8 V	S29NS-P ² 90 nm MB, 1.8 V	S29WS-P ¹ 90 nm MB, 1.8 V
≥ 256 Mb	容量 初始访问/SDR时钟 *温度范围	除非另有说明, 所有器件 都是长期性供货			512 Mb 80 ns/83 MHz * W	512 Mb 80 ns/104 MHz * W
64 - 128 Mb			256 Mb 80 ns/108 MHz * W, I	256 Mb 80 ns/108 MHz * W, I		256 Mb 80 ns/104 MHz * W
			128 Mb 80 ns/108 MHz * W, I	128 Mb 80 ns/108 MHz * W, I		128 Mb 80 ns/104 MHz * W
			64 Mb 80 ns/108 MHz * W, I	64 Mb 80 ns/108 MHz * W, I		
≤ 32 Mb	32 Mb 54 ns/75 MHz * I, A, N, M, H, T	32 Mb 54 ns/75 MHz * I, A, N, M, H, T				
	16 Mb 54 ns/66 MHz * I, A, N, M, H, T	16 Mb 54 ns/66 MHz * I, A, N, M, H, T				

* W = 无线: -25°C 到+85°C
 I = 工业级: -40°C 到+85°C
 A = 汽车级, AEC-Q100等级3: -40°C到+85°C
 N = 扩展范围: -40°C 到+125°C
 M = 汽车级, AEC-Q100等级1: -40°C到+125°C
 T = 汽车级, AEC-Q100等级0: -40°C到+150°C

¹ ADP (地址-数据并行) 突发
² AADM (高位地址、低位地址、数据复用) 突发
³ ADM (地址-数据复用) 突发



KGD NOR Flash存储器产品系列

	HyperFlash 3.0 V	HyperFlash 1.8 V	Quad SPI 3.0 V	Quad SPI 1.8 V	并行 3.0 V
	容量 初始访问/DDR时钟 *温度范围		容量 SDR时钟/DDR时钟 *温度范围		容量 初始/页访问 *温度范围
≥ 256 Mb	KL-S 512 Mb 96 ns/100 MHz * I, V, N KL-S 256 Mb 96 ns/100 MHz * I, V, N	KS-S 512 Mb 96 ns/166 MHz * I, V, N KS-S 256 Mb 96 ns/166 MHz * I, V, N	FL-S 512 Mb 133 MHz/80 MHz * I, V FL-L 256 Mb 133 MHz/66 MHz * I, V, N	FS-S 256 Mb 133 MHz/80 MHz * I, V	GL-S 1 Gb 100 ns/15 ns * I, V GL-S 512 Mb 100 ns/15 ns * I, V GL-S 256 Mb 90 ns/15 ns * I, V
64 - 128 Mb	KL-S 128 Mb 96 ns/100 MHz * I, V, N	KS-S 128 Mb 96 ns/166 MHz * I, V, N Q317	FL-L 128 Mb 133 MHz/66 MHz * I, V, N FL-L 64 Mb 108 MHz/54 MHz * I, V, N	FS-S 128 Mb 133 MHz/80 MHz * I, V FS-S 64 Mb 133 MHz/80 MHz * I, V, N	GL-S 128 Mb 90 ns/15 ns * I, V
< 64 Mb	除非另有说明， 所有器件 都是长期性供货				AL-J 16 Mb 55 ns/-- * I, V, N AL-J 8 Mb 55 ns/-- * I, V, N

*I = 工业级: -40°C 到+85°C
 V = 扩展的工业级: -40°C 到+105°C
 N = 扩展范围: -40°C 到+125°C

请联系销售人员获取KGD数据手册

状态
 供货

概念

开发中

采样 QQYY

量产 QQYY
QQYY

EOL (最后供货)

NAND系列解码



NAND Flash存储器产品蓝图

产品系列	容量	(量产) [EOL]	2017				2018				2019				2020				2021			
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
S34MS-3 16 nm SLC, ONFI 1.0 1.8 V	16 Gb 8 Gb 4 Gb 2 Gb 1 Gb	(待定) (待定) (Q4'18) (待定) (待定)																				
S34MS-2 32 nm SLC, ONFI 1.0 1.8 V	16 Gb 8 Gb 4 Gb 2 Gb 1 Gb																					
S34MS-1 4x nm SLC, ONFI 1.0 1.8 V	4 Gb 2 Gb 1 Gb	[Q2'19] [Q2'19] [Q2'19]																				
S34SL-2 32 nm SLC, ONFI 1.0 3.0 V	4 Gb 2 Gb 1 Gb																					
S34ML-3 16 nm SLC, ONFI 1.0 3.0 V	16 Gb 8 Gb 4 Gb 2 Gb 1 Gb	(待定) (待定) (Q2'18) (待定) (待定)																				
S34ML-2 32 nm SLC, ONFI 1.0 13.0 V	16 Gb 8 Gb 4 Gb 2 Gb 1 Gb																					
S34ML-1 4x nm SLC, ONFI 1.0 3.0 V	8 Gb 4 Gb 2 Gb 1 Gb	[Q2'19] [Q2'19] [Q2'19] [Q2'19]																				



除非另有说明，
所有器件都是长期性供货



SLC NAND系列产品

		S34ML-1 ¹ 4x nm, 3.0 V SLC, ONFI 1.0 ²	S34ML-2 ³ 32 nm, 3.0 V SLC, ONFI 1.0 ²	S34ML-3 ¹ 16 nm, 3.0 V SLC, ONFI 1.0 ²	S34SL-2 ^{3, 4} 32 nm, 3.0 V SLC, ONFI 1.0 ²	S34MS-1 ¹ 4x nm, 1.8 V SLC, ONFI 1.0 ²	S34MS-2 ³ 32 nm, 1.8 V SLC, ONFI 1.0 ²	S34MS-3 ¹ 16 nm, 1.8 V SLC, ONFI 1.0 ²
8 - 16 Gb	容量; 总线宽度 接口带宽 *温度范围							
	除非另有说明, 所有器件 都是长期性供货							
			16 Gb; x8 40 MBps * I, A ⁵ , V ⁵ , B ⁵	16 Gb; x8 40 MBps * I, A, V, B			16 Gb; x8 40 MBps * I, A ⁵ , V ⁵ , B ⁵	16 Gb; x8 40 MBps * I, A, V, B
1 - 4 Gb		8 Gb; x8 40 MBps * I, A, V ⁵ , B	8 Gb; x8 40 MBps * I, A, V, B	8 Gb; x8 40 MBps * I, A, V, B			8 Gb; x8 40 MBps * I, A, V, B	8 Gb; x8 40 MBps * I, A, V, B
		4 Gb; x8/16 40 MBps * I, A, V, B	4 Gb; x8/16 40 MBps * I, A, V, B	4 Gb; x8 40 MBps * I, A, V, B	4 Gb; x8 40 MBps * I, V	4 Gb; x8 40 MBps * I, A ⁵ , V, B	4 Gb; x8/16 40 MBps * I, A, V, B	4 Gb; x8 40 MBps * I, A, V, B
		2 Gb; x8/16 40 MBps * I, A, V, B	2 Gb; x8/16 40 MBps * I, A ⁵ , V ⁵ , B ⁵	2 Gb; x8 40 MBps * I, A, V, B	2 Gb; x8 40 MBps * I, V ⁵	2 Gb; x8/16 40 MBps * I, A ⁵ , V, B	2 Gb; x8/16 40 MBps * I, A ⁵ , V ⁵ , B ⁵	2 Gb; x8 40 MBps * I, A, V, B
		1 Gb; x8 40 MBps * I, A, V, B	1 Gb; x8/16 40 MBps * I, A, V, B	1 Gb; x8 40 MBps * I, A, V, B	1 Gb; x8 40 MBps * I, V	1 Gb; x8/16 40 MBps * I, A ⁵ , V, B	1 Gb; x8/16 40 MBps * I, A, V, B	1 Gb; x8 40 MBps * I, A, V, B

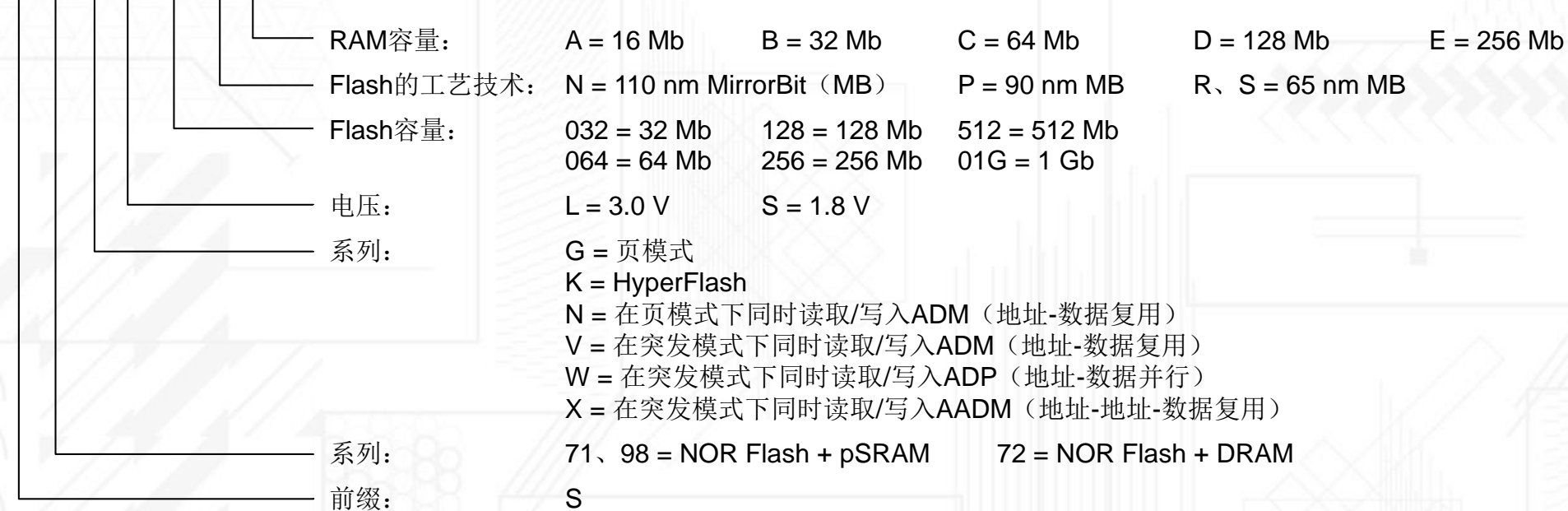
* I = 工业级: -40° C到+85° C
 A = 汽车级, AEC-Q100等级3: -40° C到+85° C
 V = 扩展的工业级: -40° C到+105° C
 B = 汽车级, AEC-Q100等级2: -40° C到+105° C

¹ 11位纠错码 (ECC)
² 开放式NAND Flash接口
³ 4位纠错码 (ECC)
⁴ SecureNAND™: 赛普拉斯的SLC NAND Flash存储器具有全容量易失性和非易失性块保护功能
⁵ 联系销售人员

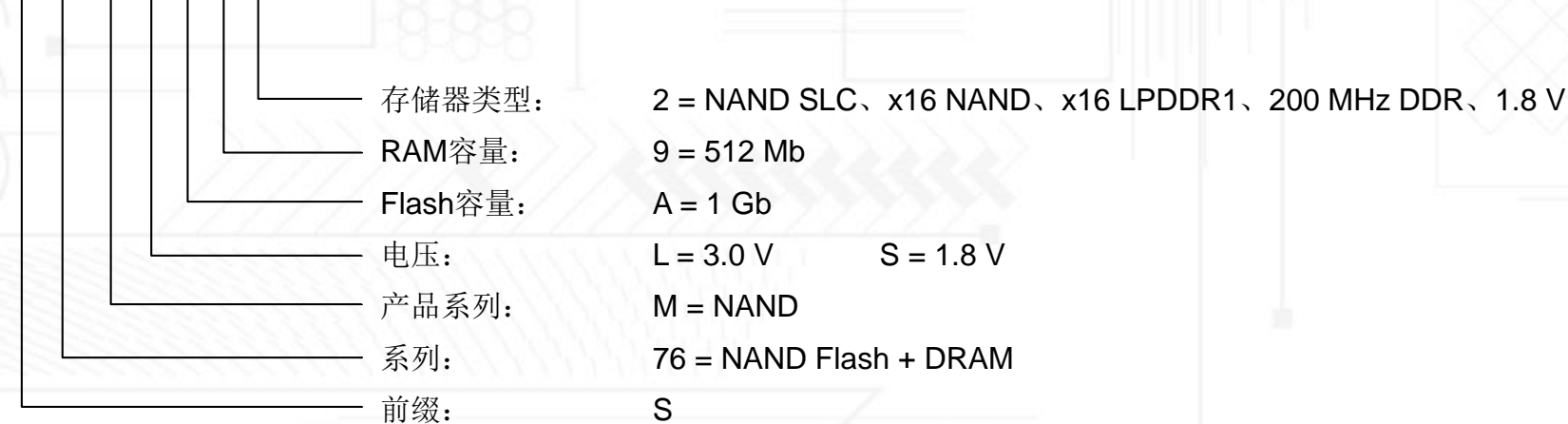


Flash和RAM MCP解码

S 71 N S 512 R D



S 76 M S A 9 2



Flash和RAM MCP存储器产品蓝图

产品系列 Flash/RAM	Flash/RAM 容量 (量产) [EOL]	2017				2018				2019				2020				2021				
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
S71KS-S HyperFlash / HyperRAM 1.8 V	512 Mb / 64 Mb (Q3'17) 256 Mb / 64 Mb (待定) 128 Mb / 64 Mb (待定)																					
S71KL-S HyperFlash / HyperRAM 3.0 V	512Mb / 64 Mb 256 Mb / 64 Mb (Q2'17) 128 Mb / 64 Mb (待定)																					
S76MS NAND/DRAM 1.8 V	1 Gb / 512 Mb																					
S98GL-N 110 nm MB/pSRAM 3.0 V	64 Mb / 32 Mb																					
S72XS-P 65 nm MB/DRAM 1.8 V	256 Mb / 256 Mb																					
S72VS-R 65 nm MB/DRAM 1.8 V	256 Mb / 256 Mb																					
S71VS-R 65 nm MB/pSRAM 1.8 V	256 Mb / 128 Mb 256 Mb / 64 Mb 128 Mb / 64 Mb 128 Mb / 32 Mb 64 Mb / 32 Mb																					
S71NS-P 90 nm MB/pSRAM 1.8 V	512 Mb / 128 Mb																					
S71WS-P 90 nm MB/pSRAM 1.8 V	256 Mb / 64 Mb																					

除非另有说明,
所有器件都是长期性供货



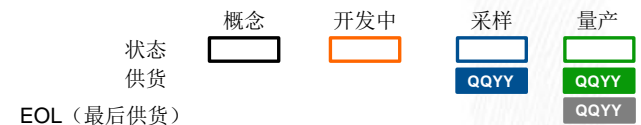
Flash和RAM MCP存储器产品系列

	S71WS-P ¹ 90 nm MB, 1.8 V	S71NS-P ² 90 nm MB, 1.8 V	S71VS-R ² 65 nm MB, 1.8 V	S72VS-R ³ 65 nm MB, 1.8 V	S72XS-R ³ 65 nm MB, 1.8 V	S98GL-N ⁴ 110 nm MB, 3.0 V	S76MS ⁵ 32 nm MB, 1.8 V	S71KL-S ⁶ 65 nm MB, 3.0 V	S71KS-S ⁶ 65 nm MB, 1.8 V
≥ 256 Mb	Flash容量 RAM容量 *温度范围	除非另有说明, 所有器件都是 长期性供货					1 Gb 512 Mb * I	512 Mb 64 Mb ⁹ * I, A, V, B	512 Mb 64 Mb ⁹ * I, A, V, B
	256 Mb 64 Mb * W	512 Mb 128 Mb * W	256 Mb 128 Mb * W	256 Mb 256 Mb * W	256 Mb 256 Mb ⁷ * I			256 Mb 64 Mb ⁹ * I, A, V, B	256 Mb 64 Mb ⁹ * I, A, V, B
64 - 128 Mb			256 Mb 64 Mb * W		256 Mb 256 Mb ⁸ * W, I			256 Mb 64 Mb ⁹ * I, A, V, B	256 Mb 64 Mb ⁹ * I, A, V, B
			128 Mb 64 Mb * W					128 Mb 64 Mb ⁹ * I, A, V, B	128 Mb 64 Mb ⁹ * I, A, V, B
			128 Mb 32 Mb * W						
			64 Mb 32 Mb * W			64 Mb 32 Mb * I			

* W = 无线: -25°C 到+85°C
 I = 工业级: -40°C 到+85°C
 A = 汽车级, AEC-Q100等级3: -40°C到+85°C
 V = 扩展的工业级: -40°C 到+105°C
 B = 汽车级, AEC-Q100等级2: -40°C到+105°C

¹ ADP (地址-数据并行) 突发
² ADM (地址-数据复用) 突发
³ AADM (高位地址、低位地址、数据复用) 突发
⁴ 并行、页模式

⁵ NAND
⁶ HyperFlash
⁷ DRAM Version 2
⁸ DRAM版本1
⁹ HyperRAM



HyperRAM™和HyperFlash™ 封装

产品系列	容量	器件	BGA24 8 x 8 mm 5 x 5 Ball	BGA24 8 x 6 mm 5 x 5 Ball	KGD
KS-T	512 Mb	S26KS512S	CF	CF	CF
	1 Gb	S26KS01GS	CF		CF
	2 Gb	S70KS02GS	CF		
	4 Gb	S70KS04GS	CF		
KS-S	128 Mb	S26KS128S		✓	CF
	256 Mb	S26KS256S		✓	CF
	512 Mb	S26KS512S		✓	CF
	1 Gb	S70KS01GS		✓	
KL-T	512 Mb	S26KL512S	CF	CF	CF
	1 Gb	S26KL01GS	CF		CF
	2 Gb	S70KL02GS	CF		
	4 Gb	S70KL04GS	CF		
KL-S	128 Mb	S26KL128S		✓	CF
	256 Mb	S26KL256S		✓	CF
	512 Mb	S26KL512S		✓	CF
	1 Gb	S70KL01GS		✓	
KS-1	64 Mb	S26KS0641		✓	CF
	128 Mb	S70KS1281		✓	
	256 Mb	S70KS2561		✓	
KL-1	64 Mb	S26KL0641		✓	CF
	128 Mb	S70KL1281		✓	
	256 Mb	S70KL2561		✓	

CF = 联系厂家

SPI NOR Flash存储器封装

系列	容量	器件	SOIC-8 150 mil	SOIC-8 208 mil	SOIC-16 300 mil	WSON 4 x 4 mm	WSON 6 x 5 mm	WSON 8 x 6 mm	BGA24 8 x 8 mm 5 x 5 Ball	BGA24 8 x 6 mm 5 x 5 Ball	BGA24 8 x 6 mm 4 x 6 Ball	KGD
FS-T	512 Mb	S25FS512S			CF				CF	CF		CF
	1 Gb	S25FS01GS			CF				CF			CF
	2 Gb	S70FS02GS							CF			
	4 Gb	S70FS04GS							CF			
FS-S	64 Mb	S25FS064S		✓			✓			✓		✓
	128 Mb	S25FS128S		✓	CF		✓	✓		✓	✓	CF
	256 Mb	S25FS256S			✓			✓		✓	✓	✓
	512 Mb	S25FS512S			✓			✓		✓	✓	CF
	1 Gb	S70FS01GS			✓					✓		
FL-T	512 Mb	S25FL512S			CF				CF	CF		CF
	1 Gb	S25FL01GS			CF				CF			CF
	2 Gb	S70FL02GS							CF			
	4 Gb	S70FL04GS							CF			
FL-S Dual Quad	256 Mb	S79FL256S			✓							
	512 Mb	S79FL512S			✓							
	1 Gb	S79FL01GS								✓		
FL-S	128 Mb	S25FL127S		✓	✓		✓			✓	✓	
	128 Mb	S25FL128S			✓			✓		✓	✓	
	256 Mb	S25FL256S			✓			✓		✓	✓	
	512 Mb	S25FL512S			✓					✓	✓	✓
	1 Gb	S70FL01GS			✓					✓		
FL-P	32 Mb	S25FL032P		✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓
	64 Mb	S25FL064P			✓			✓		✓	✓	✓
	128 Mb	S25FL128P			✓			✓				
	128 Mb	S25FL129P			✓			✓		✓	✓	
	256 Mb	S70FL256P			✓			✓		✓		
FL-L	64 Mb	S25FL064L		✓		✓				✓	✓	CF
	128 Mb	S25FL128L		✓			✓			✓	✓	CF
	256 Mb	S25FL256L			✓			✓		✓	✓	CF
FL1-K	16 Mb	S25FL116K	✓	✓			✓			✓	✓	✓
	32 Mb	S25FL132K	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓
	64 Mb	S25FL164K		✓	✓		✓			✓	✓	✓

CF = 联系厂家
UD = 正在开发

并行NOR Flash存储器封装

系列	容量	器件	48 Ball FBGA (间距为0.8 mm)	48 Ball FBGA (间距为0.5 mm)	56 Ball BGA (间距为0.8 mm)	64 Ball BGA (间距为0.8 mm)	64 Ball 加固BGA (间距为1.0 mm)	48 Pin TSOP	56 Pin TSOP	KGD
GL-T	512 Mb	S29GL512T			✓		✓		✓	
	1 Gb	S29GL01GT			✓		✓		✓	
	2 Gb	S70GL02GT					✓			
GL-S	64 Mb	S29GL064S	✓				✓	✓	✓	
	128 Mb	S29GL128S			✓		✓		✓	✓
	256 Mb	S29GL256S			✓		✓		✓	✓
	512 Mb	S29GL512S			✓		✓		✓	✓
	1 Gb	S29GL01GS					✓		✓	✓
	2 Gb	S70GL02GS					✓			
GL-P	128 Mb	S29GL128P					✓		✓	✓
	256 Mb	S29GL256P					✓		✓	✓
	512 Mb	S29GL512P					✓		✓	
	1 Gb	S29GL01GP					✓		✓	
	2 Gb	S70GL02GP					✓			
GL-N	32 Mb	S29GL032N	✓				✓	✓	✓	✓
	64 Mb	S29GL064N	✓				✓	✓	✓	✓
PL-J	32 Mb	S29PL032J	✓		✓					
	64 Mb	S29PL064J	✓		✓					
	128 Mb	S29PL127J				✓			✓	✓
JL-J	32 Mb	S29JL032J	✓					✓		✓
	64 Mb	S29JL064J	✓					✓		✓
AL-J	8 Mb	S29AL008J	✓					✓		✓
	16 Mb	S29AL016J	✓				✓	✓		✓
AS-J	8 Mb	S29AS008J	✓					✓		✓
	16 Mb	S29AS016J	✓	✓				✓		✓

突发NOR Flash存储器封装

系列	容量	器件	44 Ball FBGA (间距为0.5 mm)	64 Ball BGA (间距为0.5 mm)	84-Ball 加固BGA (间距为0.8 mm)	80 Ball FBGA (间距为1.0 mm)	80 Pin PQFP	KGD
WS-P	128 Mb	S29WS128P			✓			
	256 Mb	S29WS256P			✓			
	512 Mb	S29WS512P			✓			
NS-P	512 Mb	S29NS512P		✓				
VS-R	64 Mb	S29VS064R	✓					
	128 Mb	S29VS128R	✓					
	256 Mb	S29VS256R	✓					
XS-R	64 Mb	S29XS064R	✓					
	128 Mb	S29XS128R	✓					
	256 Mb	S29XS256R	✓					
CD-J	16 Mb	S29CD016J				✓	✓	✓
	32 Mb	S29CD032J				✓	✓	
CL-J	16 Mb	S29CL016J				✓	✓	
	32 Mb	S29CL032J				✓	✓	

SLC NAND封装

产品系列	容量	器件	63 Ball BGA (间距为0.8 mm)	67 Ball BGA (间距为0.8 mm)	48 Pin TSOP
MS-3	1 Gb	S34MS01G3	✓		
	2 Gb	S34MS02G3	✓		
	4 Gb	S34MS04G3	✓		
	8 Gb	S34MS08G3	✓		
	16 Gb	S34MS16G3	✓		
MS-2	1 Gb	S34MS01G2	✓	✓	✓
	2 Gb	S34MS02G2	✓	✓	✓
	4 Gb	S34MS04G2	✓		✓
	8 Gb	S34MS08G2	✓		
	16 Gb	S34MS16G2	✓		
MS-1	1 Gb	S34MS01G1	✓		
	2 Gb	S34MS02G1	✓		✓
	4 Gb	S34MS04G1	✓		✓
ML-3	1 Gb	S34ML01G3	✓		✓
	2 Gb	S34ML02G3	✓		✓
	4 Gb	S34ML04G3	✓		✓
	8 Gb	S34ML08G3	✓		✓
	16 Gb	S34ML16G3	✓		✓
ML-2	1 Gb	S34ML01G2	✓	✓	✓
	2 Gb	S34ML02G2	✓	✓	✓
	4 Gb	S34ML04G2	✓		✓
	8 Gb	S34ML08G2	✓		✓
	16 Gb	S34ML16G2	✓		✓
ML-1	1 Gb	S34ML01G1	✓		✓
	2 Gb	S34ML02G1	✓		✓
	4 Gb	S34ML04G1	✓		✓
	8 Gb	S34ML08G1	✓		✓

SecureNAND封装

产品系列	容量	器件	63 Ball BGA (间距为0.8 mm)
SL-2	1 Gb	S34SL01G2	✓
	2 Gb	S34SL02G2	✓
	4 Gb	S34SL04G2	✓

Flash和RAM MCP存储器封装

产品系列	Flash 容量	RAM 容量	BGA24 8 x 6 mm 5 x 5 Ball	56 Ball 超薄型FBGA (间距为0.5 mm)	56 Ball FBGA (间距为0.8 mm)	84 Ball FBGA (间距为0.8 mm)	130 Ball BGA (间距为0.65 mm)	133 Ball FBGA (间距为0.5 mm)
S71KS-S	128 Mb	64 Mb	✓					
	256 Mb	64 Mb	✓					
	512 Mb	64 Mb	✓					
S71KL-S	128 Mb	64 Mb	✓					
	256 Mb	64 Mb	✓					
	512 Mb	64 Mb	✓					
S76MS	1 Gb	512 Mb					✓	
S98GL-N	64 Mb	32 Mb			✓			
S72XS-R	256 Mb	256 Mb						✓
S72VS-R	256 Mb	256 Mb						✓
S71VS-R	256 Mb	128 Mb		✓				
	256 Mb	64 Mb		✓				
	128 Mb	64 Mb		✓				
	128 Mb	32 Mb		✓				
	64 Mb	32 Mb		✓				
S71NS-P	512 Mb	128 Mb		✓				
S71WS-P	256 Mb	64 Mb				✓		



CYPRESS[®]
EMBEDDED IN TOMORROW[™]